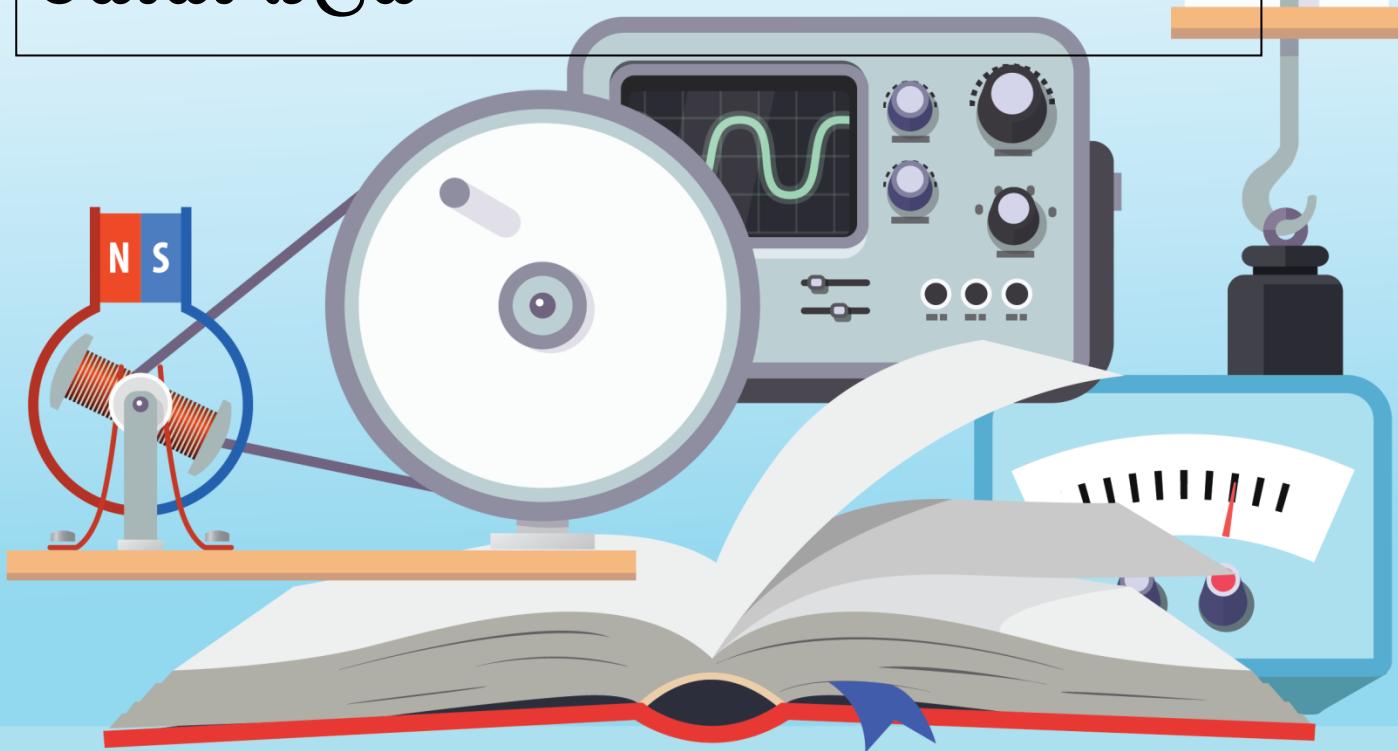
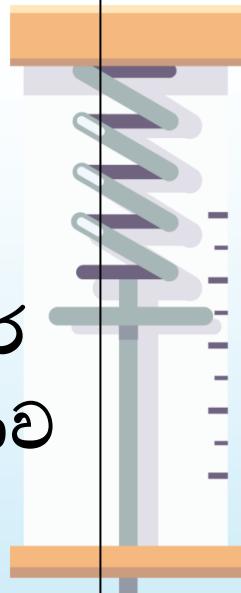


## විෂයය- ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදිය

නිපුණතාවය - 03 . ඉලෙක්ට්‍රොනික  
තාක්ෂණය එදිනෙදා හාවිතය සඳහා  
යෙදෙන ආකාරය වීමර්ණය කරයි

නිපුණතා මට්ටම- ද්වී ඔවුව චාන්සිස්ටර  
ස්විචක් ලෙස යොදාගැනීමේ හැකියාව  
සොයා බලයි



### නිපුණතාව 3

නිපුණතා මට්ටම  
3/4

- : ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය එදිනෙදා  
භාවිතය සඳහා යෙදෙන ආකාරය  
විමර්ශනය කරයි
- : දිව් ධැව ච්‍රාන්සිස්ටර ස්විචයක් මෙස  
යොදා ගැනීමේ හැකියාව සෞයා බලයි

- ප්‍රථමයෙන්ම දිව් ධැව ච්‍රාන්සිස්ටරය කුමන ස්වර්ෂපයක්ද එයට විදුලිය සපයන්නේ කටර ආකාරයකට එවිට එය ක්‍රියාත්මකවන්නේ කෙසේද යන්න ප්‍රථමයෙන්ම දැනගත යුතුවේ මේ අනුව එය පිළිබඳව පහත තොරතුරු ගැන විමසා බැලිය යුතුවේ

### ච්‍රාන්සිස්ටරය ( Transistor )

මෙයික්ස්ටර්ගේ නොහැර වෙත ලබා දෙන සංඛ්‍යාව, රැස්ප්‍රාහිති ගුවන් විදුලි තරංග අප ලබා දෙන්නේ ඉනා කුඩා සංඛ්‍යාවක් ආකාරයට වේ. මේවා එකල ව්‍යුහය කරනු ලැබූවේ රික්තක නල මගිනි. මේවා එම කාර්යයන් කිරීමේදී ඉනා ඉහළ බාරාවන් ලබා ගන්නා නිසා ඉනා විශාල මෙස ගක්ති භාවිතයක් සිදු වන අතරම එය අකාර්යක්ෂම කුමයක් වේ. මෙය විශාල අවකාශයක්ද ගන්නා බැවින් භාවිතා කරන ලද උපාංගයද ප්‍රමාණායයන් විශාල වේ.

මේ හේතුවට පිළියායක් මෙස ඇමරිකානු බෙල් පර්යේෂණයන්හේ ස්විච කරන හොතික විද්‍යාඥවරුන් තියුණෙනු විසින් පළමුව ච්‍රාන්සිස්ටරය නම් වූ උපාංගය ත්‍රීමාණය කරන ලදී. එය 1947 දී වූ අතර එම හොතික විද්‍යාඥවරුන් වන්නේ ඇමරිකානු ජාතික පෝත් බාර්ඩීන් ( Jhon Bardeen ) ,වෝල්ටර් බුටන් ( Walter Brattton ) විලියම් සොක්ලි ( William Shokly) යන තියුණාය.



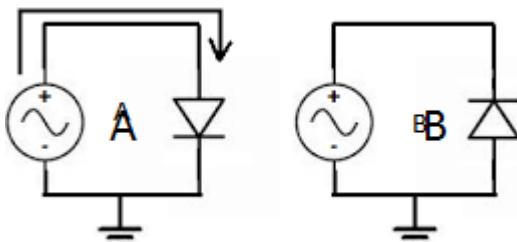
පළමුව හික්සාඩය කරන ලද ච්‍රාන්සිස්ටරය මෙම ආකාරය ගනියි



නැවත මතකයන් සොයා බැඳීම

- 1 අර්ධ සන්නායක මුල දුවස මොනවාද සඳහන් කරන්න ?
- 2 මාත්‍රනය යනු කමක්ද ?
- 3 P වර්ගයේ අර්ධ සන්නායක කුමන ආකාරයකට තිර්මාණය කරයි ද?
- 4 N වර්ගයේ අර්ධ සන්නායක කුමන ආකාරයකට තිර්මාණය කරයි ද?
- 5 PN සන්ධියේ රුප සටහක් අරද එය පැහැදිලි ආකාරයට නම් කරන්න ?

6

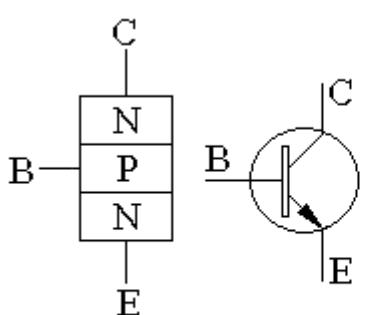


රුපයෙන් දක්වා ඇත්තේ මොනවාද යන්න දක්වන්න ?

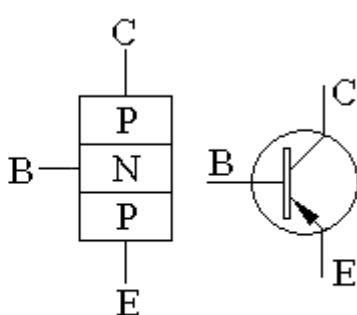
A. ....  
.....  
.....

B. ....  
.....  
.....

NPN හා PNP වර්ගයේ ව්‍යුහක්ෂර ( npn & pnp Transistors )



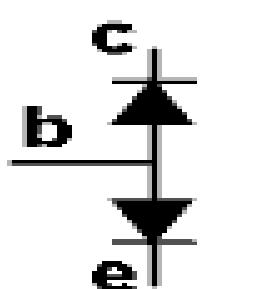
NPN Transistor



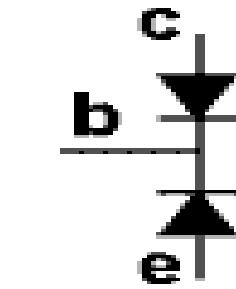
PNP Transistor

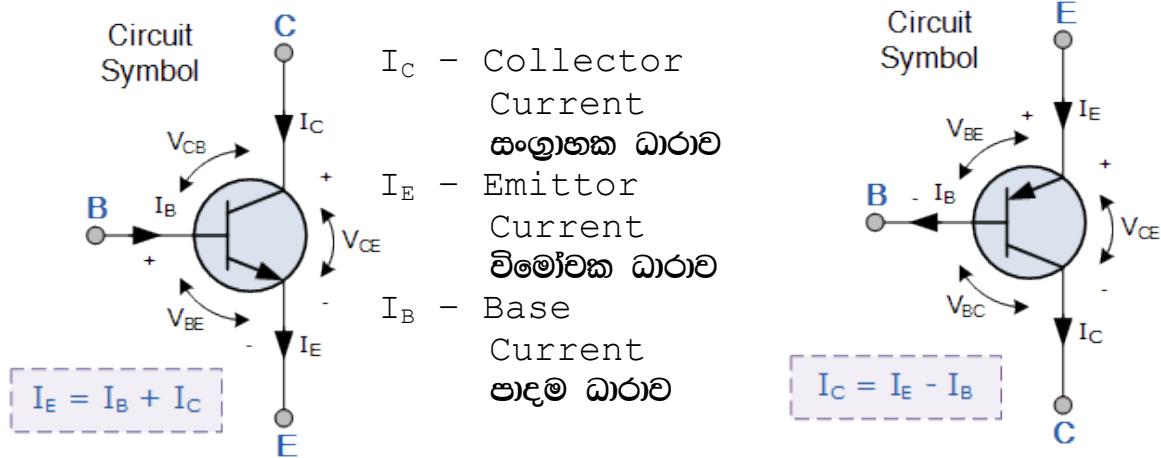
NPN වර්ගයේ ව්‍යුහක්ෂර

PNP වර්ගයේ ව්‍යුහක්ෂර



C -Collector  
සංග්‍රහකය  
E -Emitter  
වීමෝවකය  
B -Base  
පාදම





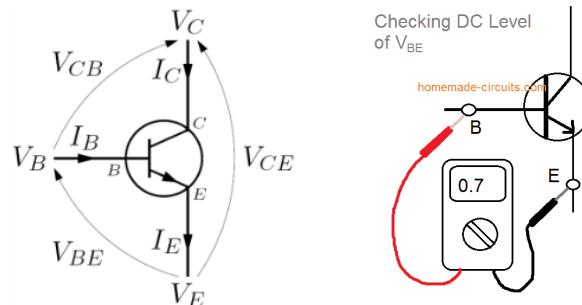
ඉහත දක්වා ඇති ආකාරයට NPN හා PNP අවස්ථාවන් දෙක සඳහා විකම බාරාවක් වුවන් බාරාවන්ගේ දිගාව වෙනක් වන බව පැහැදිලිය. නමුත් එවායේ විකමුව විකම අගයක් ගන්නා බව දක්නට ලැබේ.

මෙති  $I_B$  බාරාව ඉතා කුඩා විකමි. විය කාමාන්සයෙන්  $\mu\text{A}$  අගයක් ගනිය.

මීම නිකාම බාරාව  $I_c >> I_B$  වේ

මේ නිකාම බාරාව  $I_E$  බාරාවට  $I_c$  ආකත්න ලෙසින් සමානවේ.

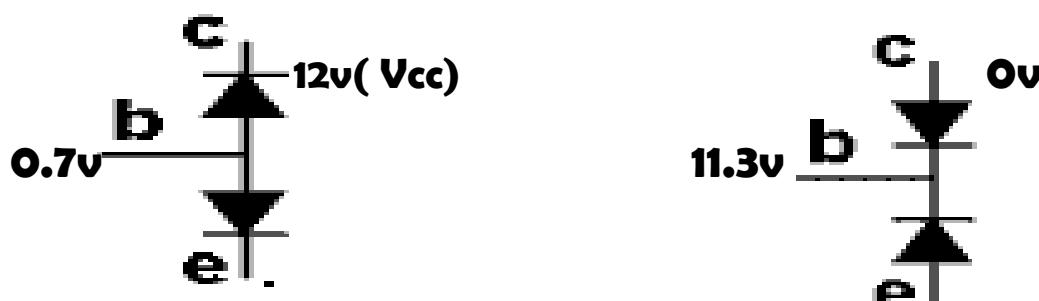
ඉහත ච්‍රාන්සිස්ටර් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නම්  $V_{BE}$  වෝල්ටෝයිනාව අනිවාර්යයෙන්ම Si වර්ගයේ නම් 0.7v හා P-මෙෂිනියම් වර්ගයේ නම් 0.3 v විය යුතුමය. මෙම කාරණාව NPN හා PNP අවස්ථාවන් දෙක සඳහා ම පොදු කාරණාවකි.

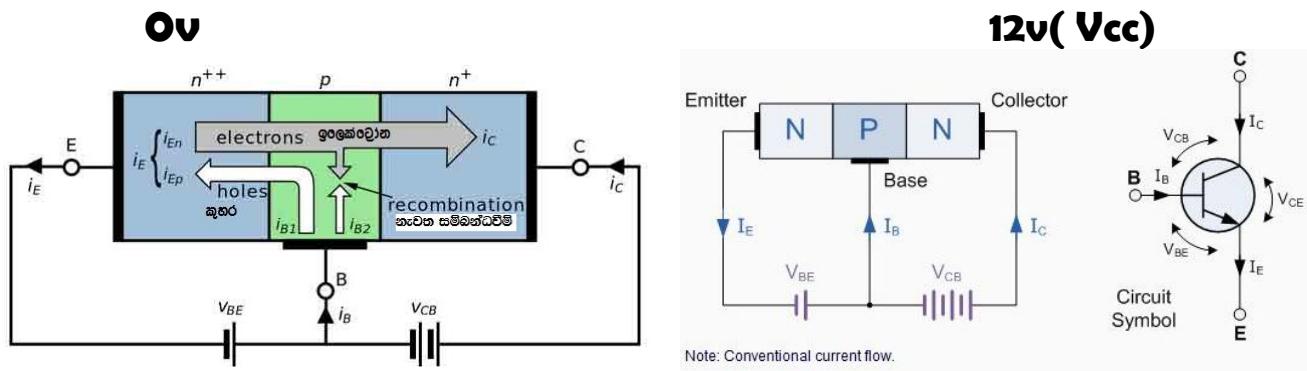


### ච්‍රාන්සිස්ටර්යේ ක්‍රියාකාරීත්වය - Action of Transistor

ච්‍රාන්සිස්ටර් බාහිරින් සපයනු ලබන නිවැරදි වෝල්ටෝයිනා සැපයුමක් නිකා එයින් ලබා ගත හැකි ප්‍රයෝගන අතිමහත්ය මේ කාරණාව සිදුවන් ආකාරය ගැන විමසා බැලීම ච්‍රාන්සිස්ටර්යේ ක්‍රියාකාරීත්වය ලෙසින් හඳුන්වනු ලබයි. මෙම ක්‍රියාකාරන ආකාරය ගැන NPN හා PNP අවස්ථාවන් දෙක සඳහා සලකා බැලීය යුතුවේ.

සම් විටකම NPN හා PNP අවස්ථාවන් දෙක සඳහා ච්‍රාන්සිස්ටර්යේ BE සන්ධිය පෝර නැඹුරුවේ (forward Bias) පවතින අතර BC සන්ධිය පසු නැඹුරුවේ (Reverse Bias) පවත්වා ගත යුතුය. විය පහත රුපයේ ඇති පරිදි වේ.





- ඉහත රුපයේ දක්වා ඇත්තේ NPN ව්‍යුහ්සිස්ටරයට විදුලිය බො දුන් විට සන්ධිය අසල සිදුවන ක්‍රියාකාරීත්වයයි
- **V<sub>BE</sub>** වෝල්ටෝයනාව කුඩා එකක් වන අතර **V<sub>CB</sub>** වෝල්ටෝයනාව ඉහළ අගයකි.
- **BE** සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු ආකාරයට සකස් කර ඇත.
- **BE** සන්ධිය පසු නැඹුරුවන ලෙස සකස් කර ඇත.
- **V<sub>BE</sub>** වෝල්ටෝයනාව **0.7V** ඉක්ම වූ විශේ **BE** සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු වන අතර එහි ගැනීම් මෙය පෙන් යොමු කරයි.
- එව්වීම් **BE** සන්ධිය නරඟා කුහර ගමන් කරන නිසා සන්නයනය වන අතර දැන් **I<sub>B</sub>** බාරාව ගලනු ඇත.
- ඒ සමගම **E** වල ඇති අධික සානා බව නිසා **E** වල සිට අධික වේගයෙන් ඉතාමත්ම සිනින් වූ බව සන්ධියේ භායනික පෙදෙස නරඟා ඉමෙක්ලේෂන් **BC** වෙත යොමු වේ.
- එව්වීම් වේගයෙන් **BC** වෙත යොමු වූ ඉමෙක්ලේෂන් **C** හි ඇති අධික දහ බව වෙත ආකර්ෂණය වේ.
- මේ නිසා **I<sub>C</sub>** බාරාව සංග්‍රාහකය නරඟා වීමෙක්වකය දෙසට ගමන් කරයි.

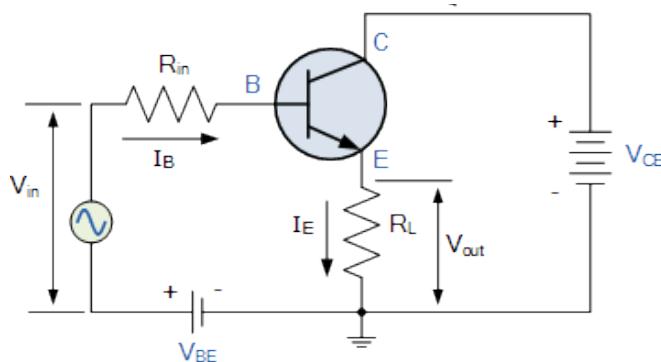
ඉහත ක්‍රියවලිය ඇසුරින් ඔබ pnp ව්‍යුහ්සිස්ටරයට විදුලිය බො දුන් විට සන්ධිය අසල සිදුවන ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ සොයා බලන්න

### ව්‍යුහ්සිස්ටරය සම්බන්ධ කරන ආකාර( Transistor Configuration )

ව්‍යුහ්සිස්ටරය අමු 3 ක ඇති බැවෙන මෙය තුම 3 කට සම්බන්ධ කළ තකිය එවා වත්තේ

- 1 පොදු විමෝචක වින්ඩාසය ( Common Emitter Configuration )
- 2 පොදු පාදම වින්ඩාසය ( Common Base Configuration )
- 3 පොදු සංග්‍රාහක වින්ඩාසය ( Common Collector Configuration )

#### 1 පොදු විමෝචක වින්ඩාසය ( Common Emitter Configuration )



ප්‍රහානය( In Put ) = BE

ප්‍රතිප්‍රහානය( Out Put ) = CE

ලක්ෂණ

1 වෝල්ට්‌මේයනු ලාභය  $A_v = V_{out}/V_{in} = V_{ce}/V_{be}$  කාමානයෙන් ඉහළ අගයක් ගනිය.

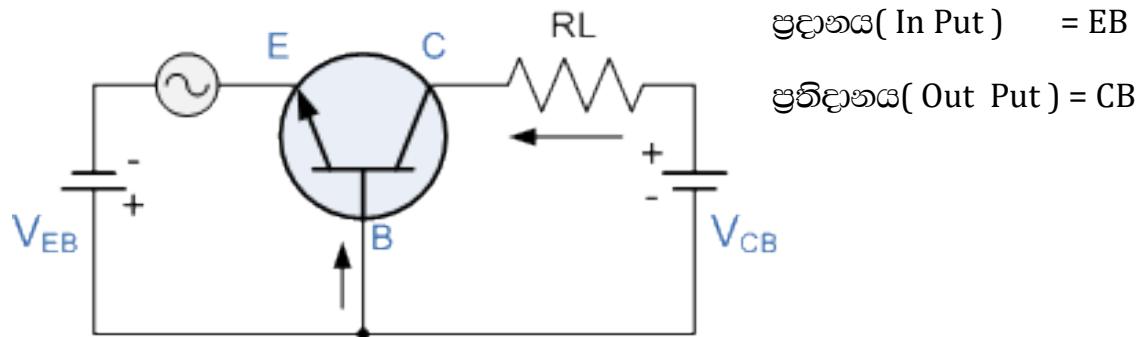
2 බරා ලාභය  $A_i = I_{out}/I_{in} = I_c/I_b$  කාමානයෙන් ඉහළ අගයක් ගනිය.

3 ප්‍රධාන ප්‍රතිරෝධය  $R_{in} = V_{be}/I_b$  කාමානයෙන් ඉහළ අගයක් ගනිය.

4 ප්‍රතිඵාන ප්‍රතිරෝධය  $R_{out} = V_{ce}/I_c$  කාමානයෙන් ඉහළ අගයක් ගනිය.

5 ප්‍රධානයට ලබාදෙන සංඛ්‍යාව  $180^\circ$  ක කළා මාරුවකට ලක්වේ.

## 2. පොදු පාදම විනාශාසය ( Common Base Configuration )



ලක්ෂණ

1 වෝල්ට්‌මේයනු ලාභය  $A_v = V_{out}/V_{in} = V_{cb}/V_{be}$  කාමානයෙන් ඉහළ අගයක් ගනිය.

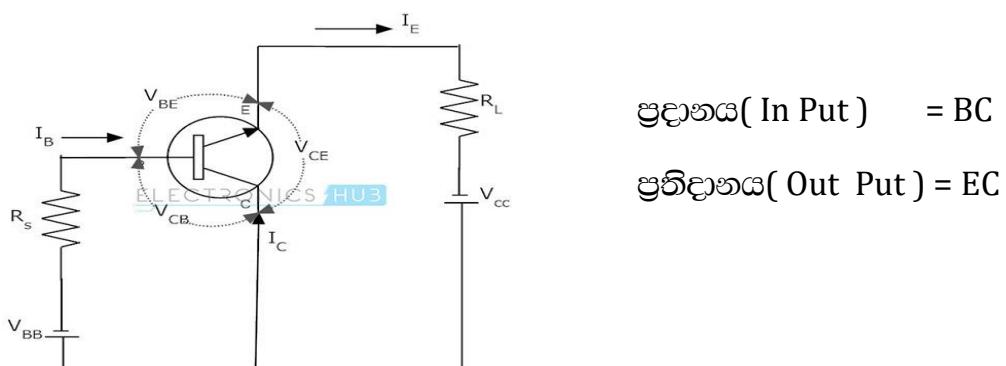
2 බරා ලාභය  $A_i = I_{out}/I_{in} = I_c/I_e$  ඉනා අඩු අගයක් ගනිය. වය 1න් අඩුය

3 ප්‍රධාන ප්‍රතිරෝධය  $R_{in} = V_{be}/I_e$  ඉනා අඩු අගයක් ගනිය.

4 ප්‍රතිඵාන ප්‍රතිරෝධය  $R_{out} = V_{cb}/I_c$  ඉනා ඉහළ අගයක් ගනිය.

5 කළා මාරුවක් නොමැත

## 3 . පොදු සංග්‍රාහක විනාශාසය ( Common Collector Configuration )



## ලක්ෂණ

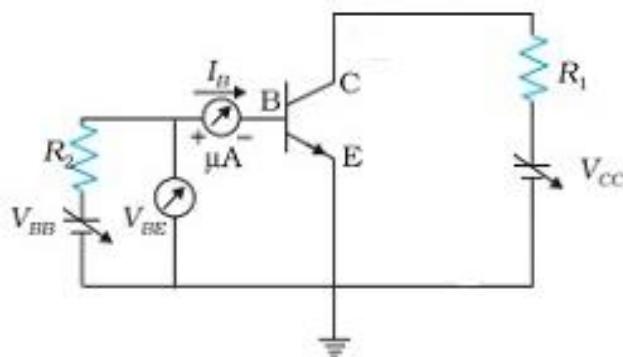
- 1 වෝල්ට්‍යෙනා ලාභය  $A_v = V_{out}/V_{in} = V_{ce}/V_{cb}$  ඉතා අඩු අගයක් ගනිය. වය 1ත් අඩුය
- 2 බාරා ලාභය  $A_i = I_{out}/I_{in} = I_c/I_b$  ඉතා ඉහළ අගයක් ගනිය.
- 3 ප්‍රධාන ප්‍රතිරෝධය  $R_{IN} = V_{bc}/I_b$  ඉතා ඉහළ අගයක් ගනිය.
- 4 ප්‍රතිඛාන ප්‍රතිරෝධය  $R_{OUT} = V_{ce}/I_c$  ඉතා අඩුම අගයක් ගනිය.
- 5 කළු මාරුවක් නොමැත

## ව්‍යාන්සිස්ටරයේ ලාක්ෂණික වතු (Transistor Characteristic Curves)

ව්‍යාන්සිස්ටරය භාවිතා කළ හැකි ආකාරය දැක්වෙන ලාක්ෂණික වතු තුනකි

- 1 ප්‍රදාන ලක්ෂණ (Input Characteristic)
- 2 ප්‍රතිඛාන ලක්ෂණ (Output Characteristic)
- 3 අනර්මැල් / කංතාමණ ලක්ෂණ (Transfer/Mutual Characteristic)

### 1 ප්‍රදාන ලක්ෂණ (Input Characteristic)

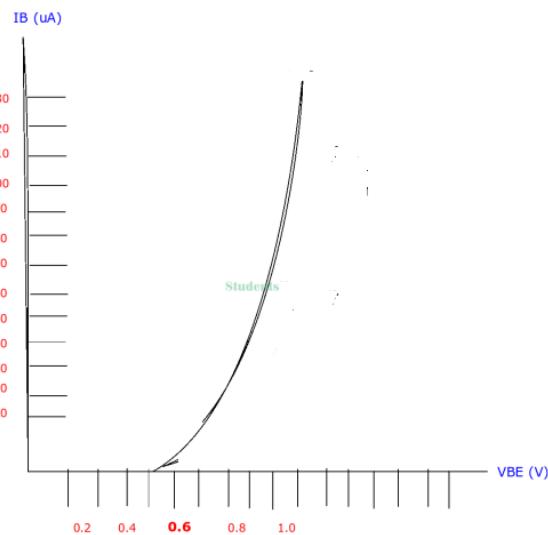


පරීක්ෂණය සිදුකරන පිළිවෙළ පහත ආකාරයට වේ

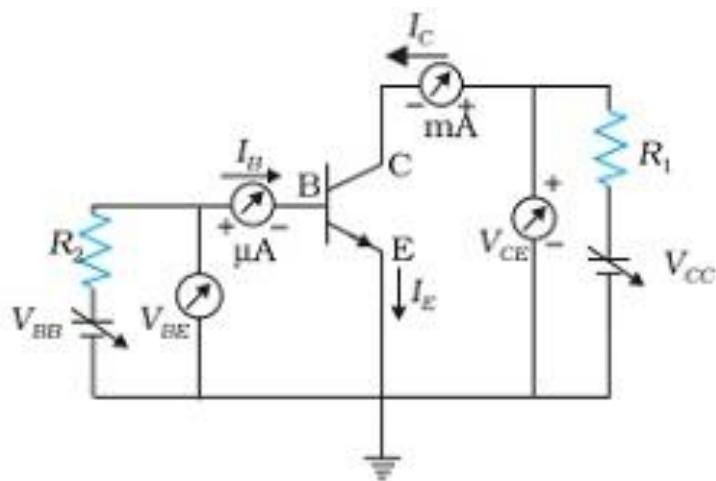
- 1 ඉහත ආකාරයට ඇවුම සකස් කරගනු බැඳී.
- 2  $I_B$  බාරාව මැනීම සඳහා මෙයිස්ටර් ආමීටරයක් පාදමට ග්‍රේනිගන ලෙස සම්බන්ධ කරනු බැඳී.
- 3 වෙනස් කරනු බැන  $V_{BB}$  වෝල්ට්‍යෙනාව මැන ගැනීම සඳහා  $V_{BE}$  වෝල්ට් මිටරය පාදමට සමාන්තර ගත ලෙස සම්බන්ධ කරනු බැඳී.
- 4 මේ කාරණාව සඳහා  $V_{CC}$  සැපයුම අවශ්‍යම නොවේ.
- 5  $V_{BB}$  විවල්ස බල සැපයුමකි.
- 6  $V_{BB}$  වෝල්ට්‍යෙනාව කුමයෙන් විශේෂ ටික (0, 0.1v, 0.2v, 0.3v, 0.4v, 0.5v, 0.6v, 0.7v, 0.8v, 0.9v, 1v) ආදි වශයෙන් වැඩිකරනු බැඳී.
- 7 ඒ අනුව වැඩිකරනු බැන සෑම  $V_{BB}$  වෝල්ට්‍යෙනාවකටම අනුරූප වන  $V_{BE}$  වෝල්ට්‍යෙනාව හා  $I_B$  බාරාව මැනීම සිදුකරනු බැඳී.
- 8 දැන් ලබා ගත්තා ලද  $V_{BE}$  වෝල්ට්‍යෙනාව අනුරූප වන  $I_B$  බාරාව ප්‍රස්ථාරගත කරනු ලැබේ.

<b>V<sub>BE</sub> (V)</b>	<b>I<sub>B</sub> (<math>\mu</math>A)</b>
0	
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	
0.5	
0.6	
0.7	
0.8	
0.9	
1	

- 9 ඉහත වගුගත කළ අගයන්ට අනුව ප්‍රස්ථාර ගත කිරීමෙන් පහත ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් ලබෙනු ඇත. එම ප්‍රස්ථාරයට චාන්ස්ස්ටරයේ ප්‍රදාන ලාංඡලීක වකුය (Input Characteristic Curve) මෙය හඳුන්වයි



## 2 ප්‍රතිඵල ලක්ෂණ (Output Characteristic)



පරික්ෂණය සිදුකරන පිළිවෙළ පහත ආකාරයට වේ

- 1 ඉහත ආකාරයට ඇටුවම සකස් කරගතු බවයි

- 2  $I_B$  බාරාව මැනීම සඳහා මෙයික්ස්ටර් ඇම්ප්‍රෝටයක් පාදමට ශේෂිත ලෙස සම්බන්ධ කරනු ලබයි
- 3  $I_C$  බාරාව මැනීම සඳහා මිලි ඇම්ප්‍රෝටයක් සංග්‍රාහකයට ශේෂිත ලෙස සම්බන්ධ කරනු ලබයි
- 4 වෙනස් කරනු ලබන  $V_{CC}$  වෝල්ටෝයනාව මැන ගැනීම සඳහා  $V_{CE}$  වෝල්ට් මිටරය සංග්‍රාහකයට හා විමෝවකයට සමාන්තර ගත ලෙස සම්බන්ධ කරනු ලබයි
- 5 මේ කාරණාව සඳහා  $V_{CC}$  විවෘෂ සැපුයුමක් අවශ්‍ය වේ
- 6  $V_{BB}$  වෝල්ටෝයනාව ක්‍රමයෙන් ටිකෙන් ටික  $I_B$  බාරාවක් ගලන තුරු වැඩිකරනු ලබයි ඉන්පසු එම  $V_{BB}$  වෝල්ටෝයනාව වෙනස් නොකර  $I_B$  බාරාව ස්ථාවරව තබනු ලැබේ
- 7 මෙවිට ලැබෙන  $I_B$  බාරාව  $I_{B1}$  ලෙසද එවිට වෙනස් වන  $I_C$  බාරාව  $I_{C1}$  බාරාව ලෙසද සලකනු ලැබේ
- 8 දැන්  $V_{CC}$  වෝල්ටෝයනාවය ක්‍රමයෙන් වැඩිකරනු ලබන අතර ( 0v , 0.5v, 1v, 1.5v, 2.0v, 2.5v, 3.0v , 3.5v, 4.0v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 12v ) කටම අනුරූප වන  $V_{CE}$  වෝල්ටෝයනාව හා  $I_C$  බාරාව මැනීම සිදුකරනු ලබයි
- 9  $I_C$  බාරාව මැනීම සිදුකරනු ලබන්නේ මිලි ඇම්ප්‍රෝටයක් භාවිතයෙනි
- 10 දැන් නැවත  $V_{BB}$  වෝල්ටෝයනාව ක්‍රමයෙන් ටිකෙන් ටික වැඩිකර පෙර අවස්ථාවට වැඩි  $I_B$  බාරාවක් ගලන තුරු විවෘතනය කරනු ලබයි
- 11 මෙවිට ලැබෙන  $I_B$  බාරාව  $I_{B2}$  ලෙසද එවිට වෙනස් වන  $I_C$  බාරාව  $I_{C2}$  බාරාව ලෙසද සලකනු ලැබේ
- 12 මෙලෙස විවධ වූ  $I_B$  බාරාවන් කෙට  $V_{CE}$  වෝල්ටෝයනාව වෙනස් කරමින් ඒට අනුරූපවන  $I_C$  බාරාව මැනීම සිදුකරමින් වගු කේ පමණ ගනු ලබයි

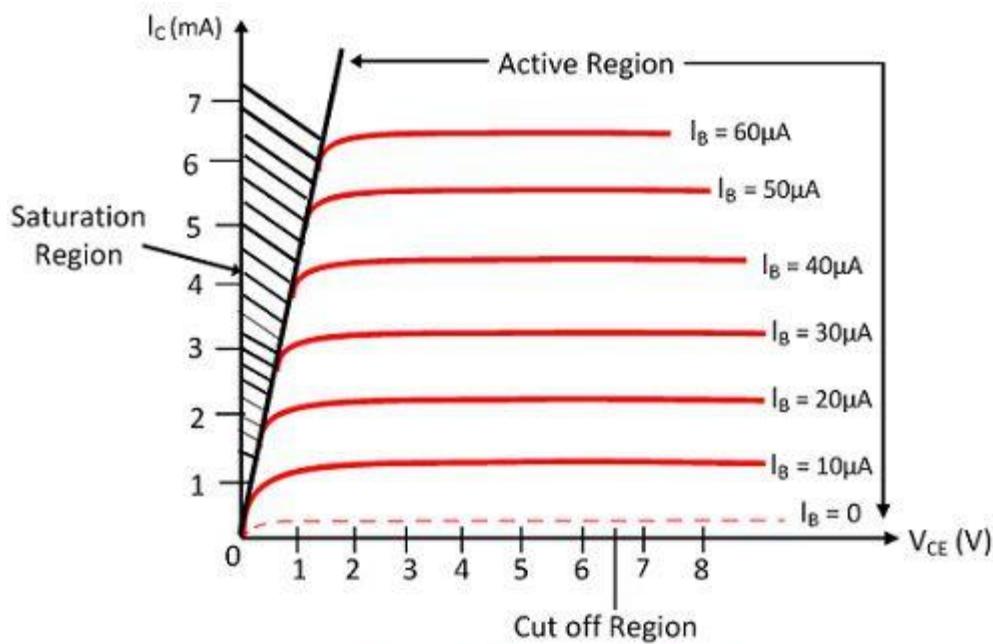
 $I_{B1}$  $I_{B2}$  $I_{B3}$  $I_{B4}$  $I_{B5}$ 

$V_{CE}$	$I_{C1}$
0	
0.5	
1.0	
1.5	
2.0	
2.5	
3.0	
3.5	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

$V_{CE}$	$I_{C3}$
0	
0.5	
1.0	
1.5	
2.0	
2.5	
3.0	
3.5	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

$V_{CE}$	$I_{C5}$
0	
0.5	
1.0	
1.5	
2.0	
2.5	
3.0	
3.5	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

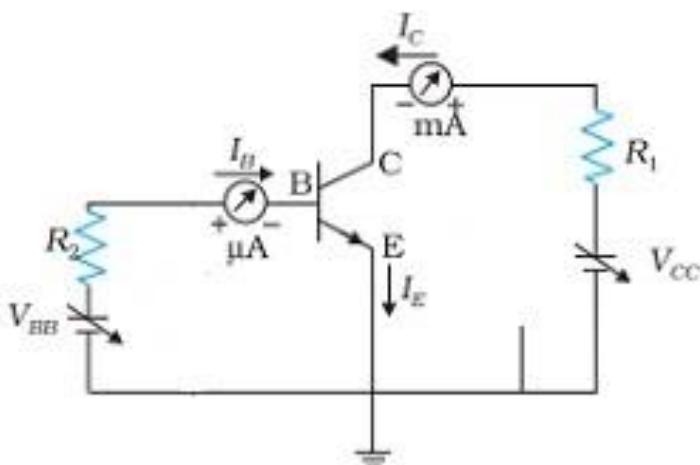
- 13 ඉහත වගුගත කළ අයයන්ට අදාළව ප්‍රස්ථාර ගත කිරීමෙන් පහත ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙනු ඇත එම ප්‍රස්ථාරයට ව්‍යුන්ස්සටරයේ ප්‍රවීදාන ලාක්ෂණික වකුය ( **Out put Characteristic Curve** ) ලෙස හඳුන්වයි



**Output Characteristic Curve**

Circuit Globe

### 3 අතරමය / සංකීර්ණ ලක්ෂණ ( Transfer/Mutual Characteristic)



පරික්ෂණය සිදුකරන පිළිවෙළ පහත ආකාරයට වේ

- 1 ඉහත ආකාරයට ඇවුම සකස් කරගෙන බැඩි
- 2  $I_B$  ධාරාව මැනීම සඳහා මෙයික්රෝ ඇමුවරයක් ප්‍රාදුමට ග්‍රෑනිගත ලෙස සම්බන්ධ කරනු බැඩි
- 3  $V_{BB}$  විවෘත බල සැපයුමකි
- 4 වෙනස් කරනු ලබන  $V_{BB}$  වෝල්ටෝයනාව යට අනුරූපව වෙස්වන  $I_B$  ධාරාව මැනීමට පාදුමට ග්‍රෑනි ගත ලෙස සම්බන්ධ කරනු බැඩි
- 5 මේ කාරණාව සඳහා  $V_{CC}$  සැපයුම ස්ථාවර තබා ගතයුතුය
- 6 ඉහත ආකාරයට වෙනස් කරනු ලබන  $V_{BB}$  වෝල්ටෝයනාව යට අනුරූපව වෙස්වන  $I_B$  ධාරාවට ද අනුරූපවන  $I_C$  ධාරාව මැනීමට සංග්‍රාහකයට ග්‍රෑනිගත ලෙස සම්බන්ධ කරන් මිලි ඇමුවරයක් භාවිතයෙනි
- 7 මෙහිදී  $I_B$  ධාරාවන් ලැබෙන ලැබෙන අගයට අඩාලව  $I_C$  ධාරාව මතිනු ලබන අතර ඒවා නියත පරාසවලින් බව ලැනීම අවශ්‍යම නොවේ
- 8 දැන් බවා ගන්නා ලද  $I_B$  ධාරාවට අනුරූප වන  $I_C$  ධාරාවන් වුගැන කර එය ප්‍රස්ථාරගත කරනු ලැබේ

$I_B (\mu A)$	$I_C (mA)$

- 10 ඉහත වගුගත කළ අගයන්ට අභාලව ප්‍රස්ථාර ගත කිරීමෙන් පහත ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙනු ඇත එම ප්‍රස්ථාරයට ව්‍යාන්ස්සටරයේ අතර මදි ලක්ෂණික වනුය ( Mutual ? Transfer Characteristic Curve ) ලෙස හඳුන්වයි

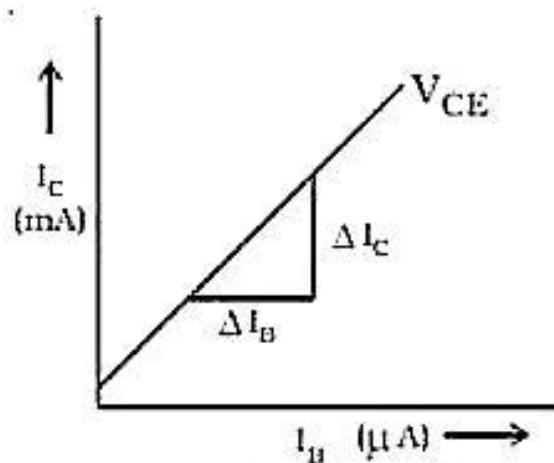


Fig Transfer characteristic curve

මෙම අනුව ඉහත සඳහන් සියලුම දේ පහත ආකාරයට සංඛ්‍යාත කිරීමට හැකිය

ලක්ෂණය	ඩාරු ලාභය $A_i$	වෛශ්ලේෂනා ලාභය $Av$	ප්‍රධාන ප්‍රතිරෝධය	ප්‍රතිධාන ප්‍රතිරෝධය	කළු මාරුජව
පොදු විමෝශක	සාමාන්‍ය ඉහළ	සාමාන්‍ය ඉහළ	සාමාන්‍ය අගයක්	සාමාන්‍ය අගයක්	$180^\circ$
පොදු පාදුම	එකටත් අඩුය	ඉතා ඉහළය	ඉතා අඩුය	ඉතා ඉහළය	-
පොදු සංග්‍රාහක	ඉතා ඉහළය	එකටත් අඩුය	ඉතා ඉහළය	ඉතා අඩුය	-

ව්‍යාන්ස්සටර් අංකන ක්‍රමය

## Pro-electron code

පලමු අංකය

**A** – Germanium

**B** – Silicon

**C** – Gallium Arsenide

**D** – Indium Antimide

දෙවන අංකය

**C** – Audio frequency Amplifier

**D** – Audio frequency power amplifier

**F** – Low power Radio frequency amplifier

**P** – High power Radio frequency amplifier

ඒ අනුව **BC548** ව්‍යාන්සිස්ටරයේ කියවීම වන්නේ

**B** – Silicon **C** – Audio frequency amplifier – Silicon Audio frequency Amplifier

**BD 140** – B – Silicon, D- Audio frequency power amplifier

**AD 140** – A – Germanium, D- Audio frequency power amplifier

**AC 187** – A- Germanium, C- Audio frequency amplifier

According to the American system, the code begins with **2N** followed by a number that indicates the time of design. A higher number indicates recent design.

### Eg. 2N 2222A

නමුත් ජපන් ක්‍රමය මගින් කේතය දැකින සැකින් එය NPN හා PNP වර්ගයේද යන්න පහසුවෙන්ම හඳුනා ගැනීමට නැකියාව ඇත එබැවින් නිසා ජපන් ක්‍රමය ලේඛයේ ජනනීයම කේත ක්‍රමයයි

$\left. \begin{matrix} \text{SA} \\ \text{A} \end{matrix} \right\}$	npn High Frequency	$\left. \begin{matrix} \text{SB} \\ \text{B} \end{matrix} \right\}$	npn Audio Frequency
---	-----------------------	---	------------------------

$\left. \begin{matrix} \text{SC} \\ \text{C} \end{matrix} \right\}$	npn High Frequency	$\left. \begin{matrix} \text{SD} \\ \text{B} \end{matrix} \right\}$	npn Audio Frequency
---	-----------------------	---	------------------------

### මතකය ආලීත් කරමු

- 1 පොදු පාදම වින්යාසය සඳහා ප්‍රභානයන් ලෙස සලකන්නේ ව්‍යාන්සිස්ටරයේ කවර අග ද?
- 2  $180^\circ$  ක කළාමාරුවක් ඇති වන්නේ ක්‍රමන වින්යාසයේද?
- 3 වෝල්ටෝමෝ ලාභය දැඟම ගණනක් ඇත්තේ මොන වින්යාසයේද?
- 4 ප්‍රභාන ලාක්ෂණික වතුය අඩුනු ලබන්නේ ක්‍රමන පාරාමිති 2ක් අතරේ ද?
- 5 ප්‍රභාන ලාක්ෂණික වතුය අඩුනු ලබන පරාමිතිවල ස්වායන්ත හා පරායන්ත ඒවා නම් කරන්න?
- 6 ප්‍රභාන ලාක්ෂණික වතුය අඩුනු ලැබේමට පායිත ලබා ගන්නා ආකාරය විස්තර කරන්න?
- 7 ප්‍රස්ථාරය ආහන රේඛාවක් ආකාරයට ලැබෙන්නේ ක්‍රමන ලාක්ෂණික වතුයටද?
- 8 ඉහත ප්‍රස්ථාරය ක්‍රමන පාරාමිති 2ක් අතරේ ද?
- 9 ව්‍යාන්සිස්ටරය ක්‍රියාත්මක වන විට එහි සන්ධි නැසිරෙන්නේ කෙලෙස ද
- 10 npn ව්‍යාන්සිස්ටරයකට සංග්‍රාහකයට -12v හා පාදමට 0.9v හා විමෝශකයට 0.1v ලබා දී ඇති නම් ක්‍රමන සන්ධි ක්‍රියාත්මක වේද?

- 11 මෙම ව්‍යුහස්ථාපනය ක්‍රියාකාරීද?
- 12 ජපන් කුමය ව්‍යුහස්ථාපනයක වර්ගය සේවීමේ තොදු කුමවේදයක් ලෙස දක්වන්නේ ඇයි
- 13 පහත අංක ඇති ව්‍යුහස්ථාපනයක් වල වර්ග සොයන්න  
 A 733 , C 1015 , B507 , D 400, A 844, C 828 , D 1061 , D 313 , A 2030 , C945,  
 B 544, A 1015, D 788, C 829, D 1555 , B 540

නිපුණතා මට්ටම  
3/5

: සංග්‍රාම ව්‍යුහය සඳහා ව්‍යුහස්ථාපනය විමසා බලයි

### ව්‍යුහස්ථාපනය නැඹුරු කිරීමේ ක්‍රම ( Transistor Biasing Methods)

ව්‍යුහස්ථාපනයක් නැඹුරු කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ව්‍යුහස්ථාපනයේ නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය බව ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වෛල්ටෝයනාවයන් සකසා දීමට වේ. මෙසේ වෛල්ටෝයනාව සැපයීමෙන් එකම බලසායුමකින් බව දීම විශේෂන්වයක් වේ. මේ අනුව නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය බව ගැනීමට විවිධ වූ කුම උපායන් සකස් කර ඇත. මෙවාට නැඹුරු පරිපර් යැයි කියනු ලැබේ.

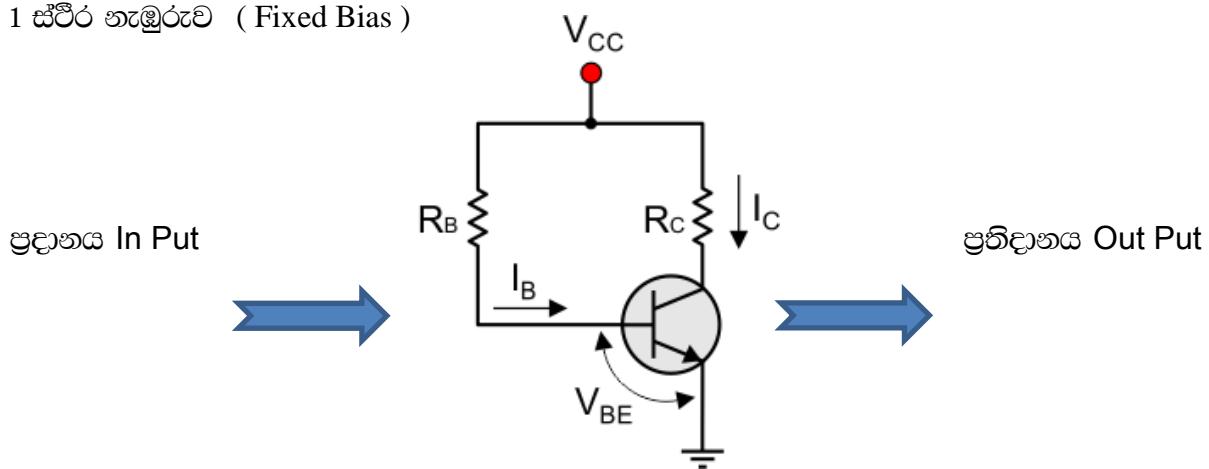
1 ස්ථේරික නැඹුරුව ( Fixed Bias )

2 ස්වයං නැඹුරුව ( Self Bias )

3 විහාර බෙදුම් නැඹුරුව ( Voltage Divided Bias )

4 විමෝචක නැඹුරුව ( Emitter Bias )

1 ස්ථේරික නැඹුරුව ( Fixed Bias )



- 1  $R_B$  ප්‍රතිරෝධකය හරහා විහාර බැස්ම  $V_{RB}$  ලෙසද  $R_C$  ප්‍රතිරෝධය හරහා විහාර බැස්ම  $V_{RC}$  ලෙසද සලකනු ලැබේ
- 2  $R_B$  ප්‍රතිරෝධකය තුළින් ගලන ධාරාව  $I_B$  ලෙසද  $R_C$  ප්‍රතිරෝධකය තුළින් ගලන ධාරාව  $I_C$  එවේ
- 3 සංග්‍රාහකය Collector ( C ) හා විමෝචකය Emitter ( E ) හරහා විහාරය  $V_{CE}$  ලෙසද සලකනු ලැබේ
- 4 පාදම Base ( B ) හා විමෝචකය Emitter ( E ) හරහා විහාරය  $V_{BE}$  ලෙසද සලකනු ලැබේ
- 5 මේ අනුව ප්‍රදානය වෛල්ටෝයනාව ගැන සලකා බැලු කළ

$$V_{CC} = V_{RB} + V_{BE}$$

$$V_{CC} = I_B \times R_B + V_{BE} \text{ ලෙසද ලිවීමට ප්‍රාග්‍රහන}$$

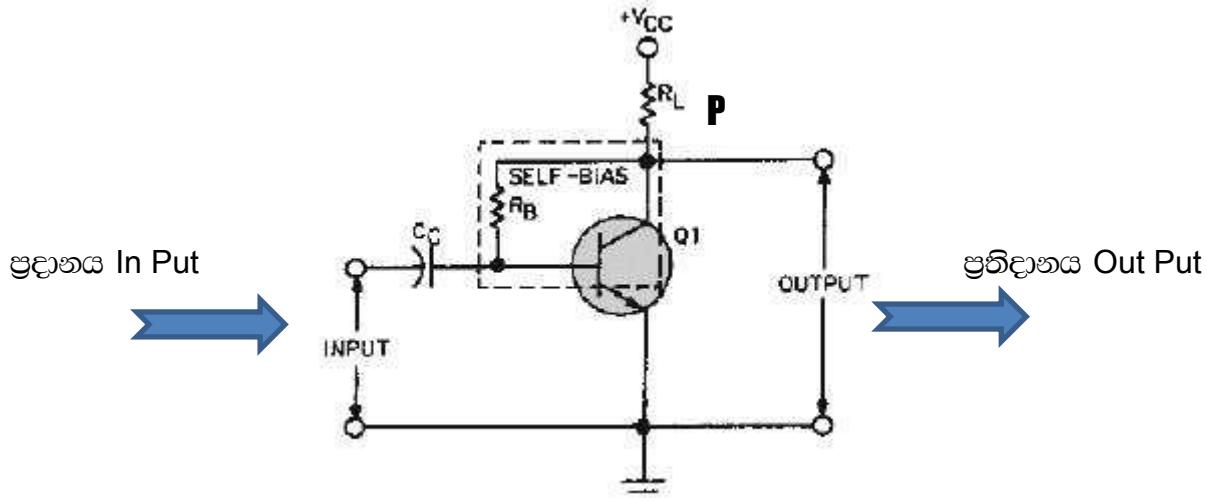
මේ අනුව ප්‍රතිදානය වෝල්ටෝයනාව ගැන සලකා බැඳු කළ

$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CE}$$

$$V_{CC} = I_C \times R_C + V_{CE} \text{ ලෙසද ලිවීමට ප්‍රාග්‍රහන}$$

තවද මෙම ව්‍යාහ්‍යිස්ටරයේ බාරා ලාභය  $\beta = I_C/I_B$  ද දැනගෙන සිටිය යුතුය.

## 2 ස්වයං නැඹුරුව ( Self Bias )



- $R_B$  ප්‍රතිරෝධකය හරහා විනව බැස්ම  $V_{RB}$  ලෙසද  $R_C$  ප්‍රතිරෝධය හරහා විනව බැස්ම  $V_{RC}$  ලෙසද සලකනු ලැබේ.
- සංග්‍රහකය Collector ( C ) නා විමෝචකය Emitter ( E ) හරහා විනවය  $V_{CE}$  ලෙසද සලකනු ලැබේ.
- $R_B$  ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගෙන බාරාව  $I_C + I_B$  වන අතර  $R_B$  හරහා  $I_B$  බාරාවද සංග්‍රහකටයට  $I_C$  බාරාව ගෙන.
- පාදම Base ( B ) නා විමෝචකය Emitter ( E ) හරහා විනවය  $V_{BE}$  ලෙසද සලකනු ලැබේ.

මේ අනුව ප්‍රතිදානය වෝල්ටෝයනාව ගැන සලකා බැඳු කළ

$$V_{CC} = V_{RB} + V_{BE} + V_{RL}$$

$$V_{CC} = I_B \times R_B + V_{RB} + (I_C + I_B) \times R_L$$

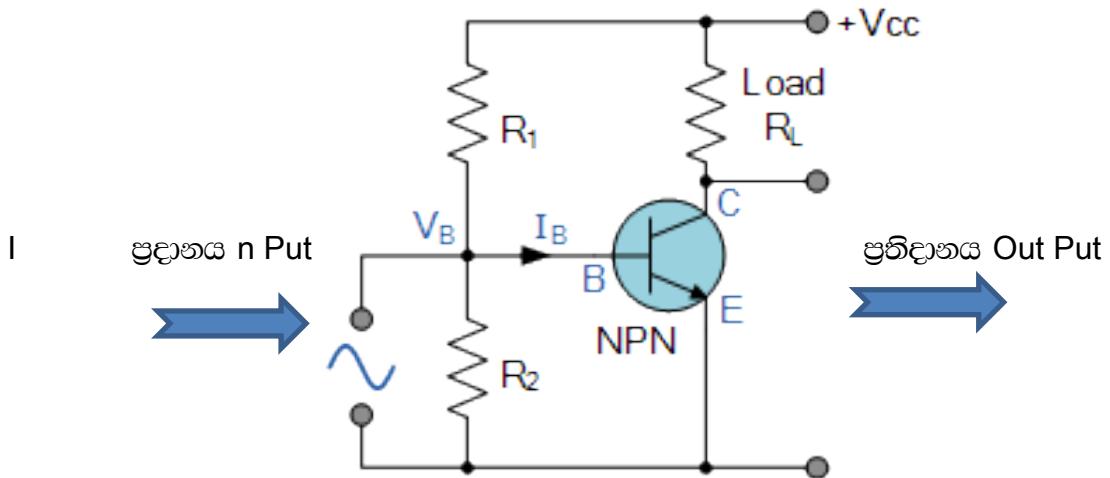
මේ අනුව ප්‍රතිදානය වෝල්ටෝයනාව ගැන සලකා බැඳු කළ

$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CE}$$

$$V_{CC} = (I_C + I_B) \times R_L + V_{CE}$$

තවද මෙම ව්‍යාහ්‍යිස්ටරයේ බාරා ලාභය  $\beta = I_C/I_B$  ද දැනගෙන සිටිය යුතුය.

### 3 විනව බෙදුම් නැඹුරුව ( Voltage Divided Bias )



- 1  $R_2$  ප්‍රතිරෝධකය හරහා විනව බැස්ම  $V_{R2}$  මෙසය  $R_1$  ප්‍රතිරෝධය හරහා විනව බැස්ම  $V_{R1}$   $R_L$  ප්‍රතිරෝධය හරහා විනව බැස්ම  $V_{RL}$  මෙසය සලකනු ලැබේ.
- 2 සංග්‍රහකය Collector ( C ) හා විමෝචකය Emitter ( E ) හරහා විනවය  $V_{CE}$  මෙසය සලකනු ලැබේ.
- 3  $R_1$  ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගෙන ධාරාව  $I_C$  වන අනර  $R_1$  හරහා  $11 \times I_B$  ධාරාවද  $R_2$  හරහා  $10 \times I_B$  ධාරාවද ( ඉහත සඳහන්  $11I_B$  හා  $10I_B$  ධාරාවන් ගණන නිර්මාණය කරන්න ) අනුව වෙනස් වේ ).
- 4 පාදම Base ( B ) හා විමෝචකය Emitter ( E ) හරහා විනවය  $V_{BE}$  මෙසය සලකනු ලැබේ
- 5 මෙහි  $V_{BE}$  විනවයට  $V_{R2}$  විනව බැස්මට සමාන වේ  
මේ අනුව ප්‍රතිඵ්‍යුහය වේල්ල්වීයනාව ගැන සලකා බැහු කළ

$$V_{CC} = V_{RA} + V_{RB}$$

$$V_{CC} = 11I_B \times R_A + 10I_B \times R_B$$

$$10I_B \times R_B = V_{RB}$$

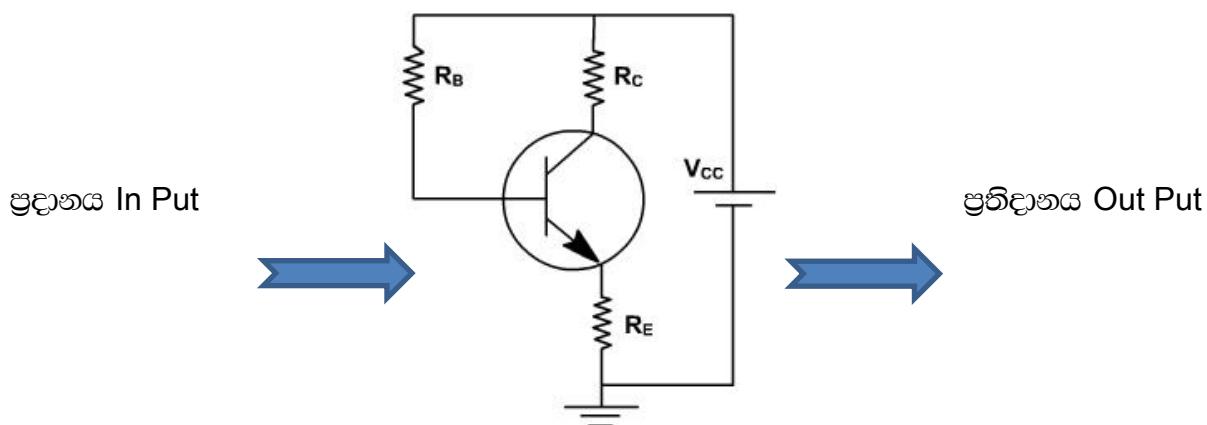
මේ අනුව ප්‍රධානය වේල්ල්වීයනාව ගැන සලකා බැහු කළ

$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CE}$$

$$V_{CC} = I_C \times R_L + V_{CE}$$

තවද මෙම උළුස්සිස්ටරයේ ධාරා ලාභය  $\beta = I_C/I_B$  ද දැනගෙන සිටිය යුතුය.

### 4 විමෝචක නැඹුරුව ( Emitter Bias )



1

- 2  $R_B$  ප්‍රතිරෝධකය හරහා විනව බැස්ම  $V_{RB}$  ලෙසද  $R_C$  ප්‍රතිරෝධය හරහා විනව බැස්ම  $V_{RC}$   
 $R_E$  ප්‍රතිරෝධය හරහා විනව බැස්ම  $V_{RE}$  ලෙසද සලකනු ලැබේ.
- 3 සංග්‍රහකය Collector (C) හා විමෝචකය Emitter (E) ගරහා විනවය  $V_{CE}$  ලෙසද  
 සලකනු ලැබේ.
- 4  $R_E$  ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගෙන ඩාරුව  $I_C$  වන අතර  $R_B$  ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගෙන ඩාරුව  $I_B$  වන අතර  $R_E$  ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගෙන ඩාරුව  $I_E$  ද වේ
- 5  $I_E = I_B + I_C$  වන බවින්
- 6 මෙහි  $V_{BE}$  විනවයට  $V_{B2}$  විනව බැස්මට සමාන වේ  
 මේ අනුව ප්‍රතිදානය වෝල්ටෝමෝටරුව ගැන සලකා බැලු කළ

$$V_{CC} = V_{RB} + V_{BE}$$

$$V_{CC} = I_B \times R_B + V_{BE}$$

මේ අනුව ප්‍රතිදානය වෝල්ටෝමෝටරුව ගැන සලකා බැලු කළ

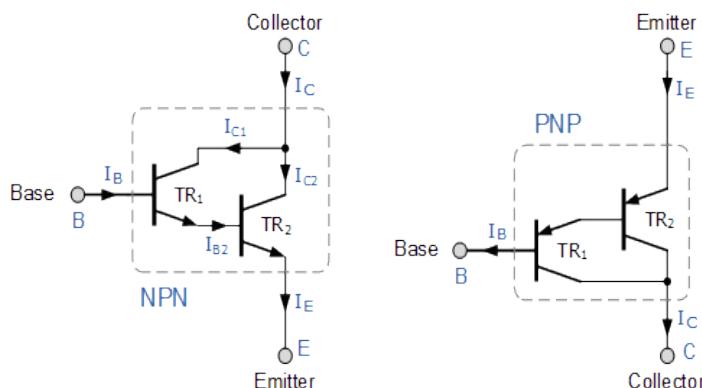
$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CE} + V_{RE}$$

$$V_{CC} = I_C \times R_L + V_{CE} + I_E \times R_E$$

නවද මෙම ව්‍යාහ්සිස්ටරයේ ඩාරු ලාභය  $\beta = I_C/I_B$  ද දැනගෙන සිටිය යුතුය.

### බාර්ලින්ටන් ග්‍රෑන්මය (Darlington Pair)

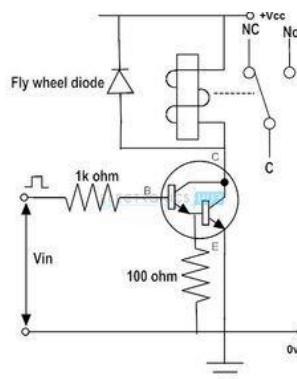
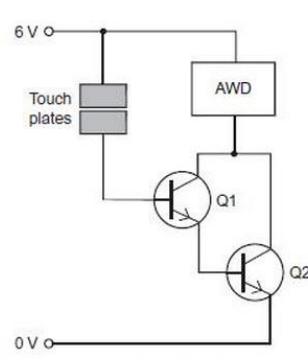
ව්‍යාහ්සිස්ටරය යනු ඩාරු පාලන උපාංගයකි. නමුත් එය සීමාසහිත වේ. වැඩිපූර බාරවක් පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට බාර්ලින්ටන් ග්‍රෑන්මය හාටිනා කරනු ලබයි.



මෙතිදී හාටිනා කරනු ලබන්නේ එකම වර්ගයේ සමාන හෝ අඩු හා වැඩි ජව ප්‍රමාණයන් ඇති ව්‍යාහ්සිස්ටරයන් දෙකකි. මෙම ව්‍යාහ්සිස්ටරයේ ඩාරු ලාභය ලැබෙනුයේ යොදාගෙන ඇති ව්‍යාහ්සිස්ටර දෙකේ ඩාරු ලාභයන් දෙක වෙන වෙනම ගුණ කිරීමෙනි.

පළමු ව්‍යාහ්සිස්ටරයේ ඩාරු ලාභය  $\beta_1$  ද දෙවන ව්‍යාහ්සිස්ටරයේ ඩාරු ලාභය  $\beta_2$  ද නම් සම්පූර්ණ ඩාරු ලාභය

$$\beta = \beta_1 \times \beta_2$$



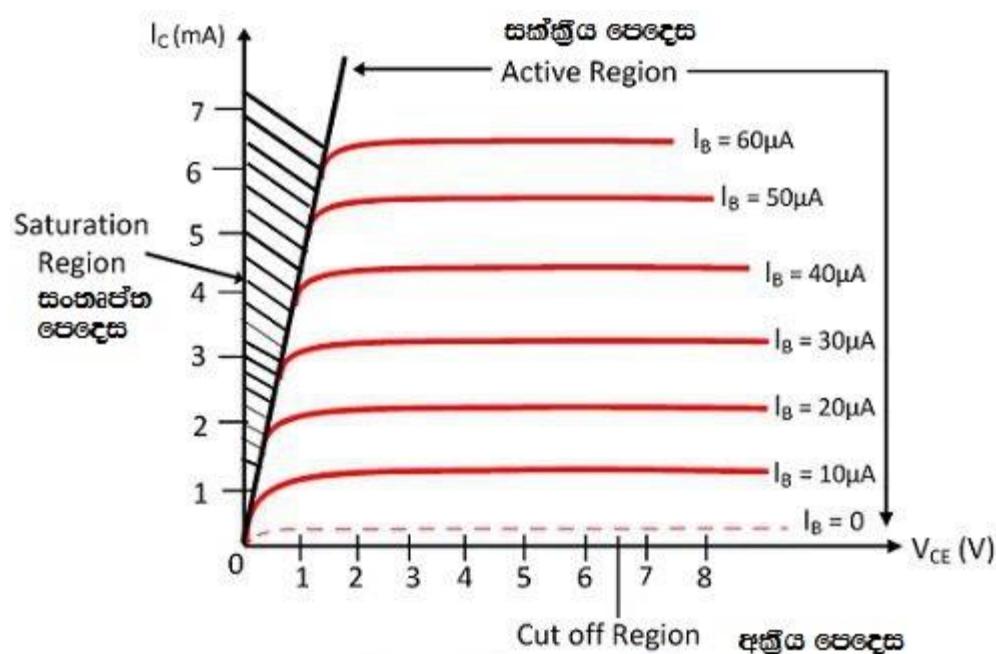
## ව්‍යුත්සිස්ටරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ( Action Of Transistor )

1 වර්ධකයක් ලෙස ( As an Amplifier)

2 ස්විචක් ලෙස ( As a Switch)

### 1 වර්ධකයක් ලෙස භාවිතා වන ආකාර

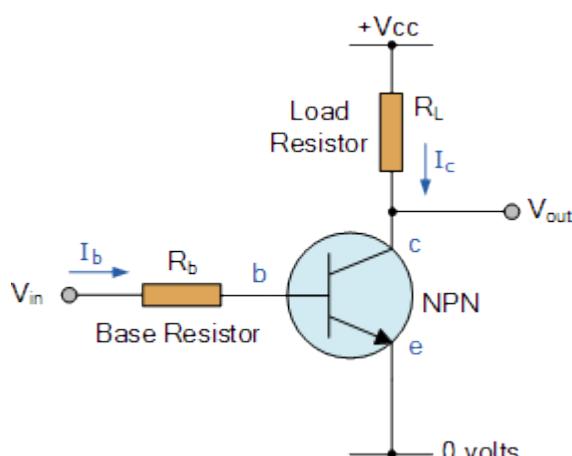
ව්‍යුත්සිස්ටරය වර්ධකයක් ලෙස භාවිතා වන්නේ ක්‍රියාකාරී කොටස්සීය (Active Region). ක්‍රියාකාරී කොටස ව්‍යුත්සිස්ටරයක ඇත්තේ කොහොදුයි සොයා බැලිය යුතුවේ මෙම කාරණාව ගැන සොයා බැලිමට ව්‍යුත්සිස්ටරයේ ප්‍රතිඵාහ ලාක්ෂණික වතුය (Output Characteristic Curve) උපයෝගී කරගත යුතුය එය පහත ආකාරවේ නමුත් වර්ධනය කුමන ස්ථානවක සිට සිදුවන්නේද යන්න සොයා බැලිමට ව්‍යුත්සිස්ටරයේ සරල බාරා බැර රේබාව (DC Load Line) ගැන අවබෝධයක් තිබේය යුතුවේ සරල බාරා බැර රේබාව මත ව්‍යුත්සිස්ටරයේ ක්‍රියාකාරී ලක්ෂය (Operating Point) හෝත් නිවාත ලක්ෂය (Q Point) නිඛෙන ස්ථානය අනුව වේ



Output Characteristic Curve

Circuit Globe

බැර රේබාව නිවැරදි ආකාරයට සකස්කර ගන්නා ආකාරය ගැන සලකා බලමු මේ සඳහා භාවිතා කරනු ලබන්නේ ව්‍යුත්සිස්ටරයේ ප්‍රතිඵාහ කොටස වේ.



මෙති ප්‍රතිඵලන කොටස රැගෙන සලකා බැවු වට

$$V_{CC} = V_{RL} + V_{CE} \text{ වේ}$$

$$V_{CC} = I_C \times R_L + V_{CE} \text{ ලෙස දැක්වීමට හැකියාව ඇත}$$

නමුත් මෙම ව්‍යුහ්සිස්ටරයට අවස්ථාවන් දෙකක් ගෙන සලකා බැලිය යුතුවේ.

එනම් ව්‍යුහ්සිස්ටරය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාව හා ව්‍යුහ්සිස්ටරය අක්‍රිය අවස්ථාව වේ.

ව්‍යුහ්සිස්ටරය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාව

ව්‍යුහ්සිස්ටරය අක්‍රිය අවස්ථාව

උපරිම බාරාව ගෙන්නේ යැයි සිතා

උපරිම බාරාව නොගෙන්නේ යැයි සලකා

$$V_{CC} = I_C \times R_L + V_{CE}$$

$$V_{CC} = I_C \times R_L + V_{CE}$$

උපරිම බාරාව  $I_{C \max}$  අවස්ථාවේදී  $V_{CE} = 0V$  වේ.

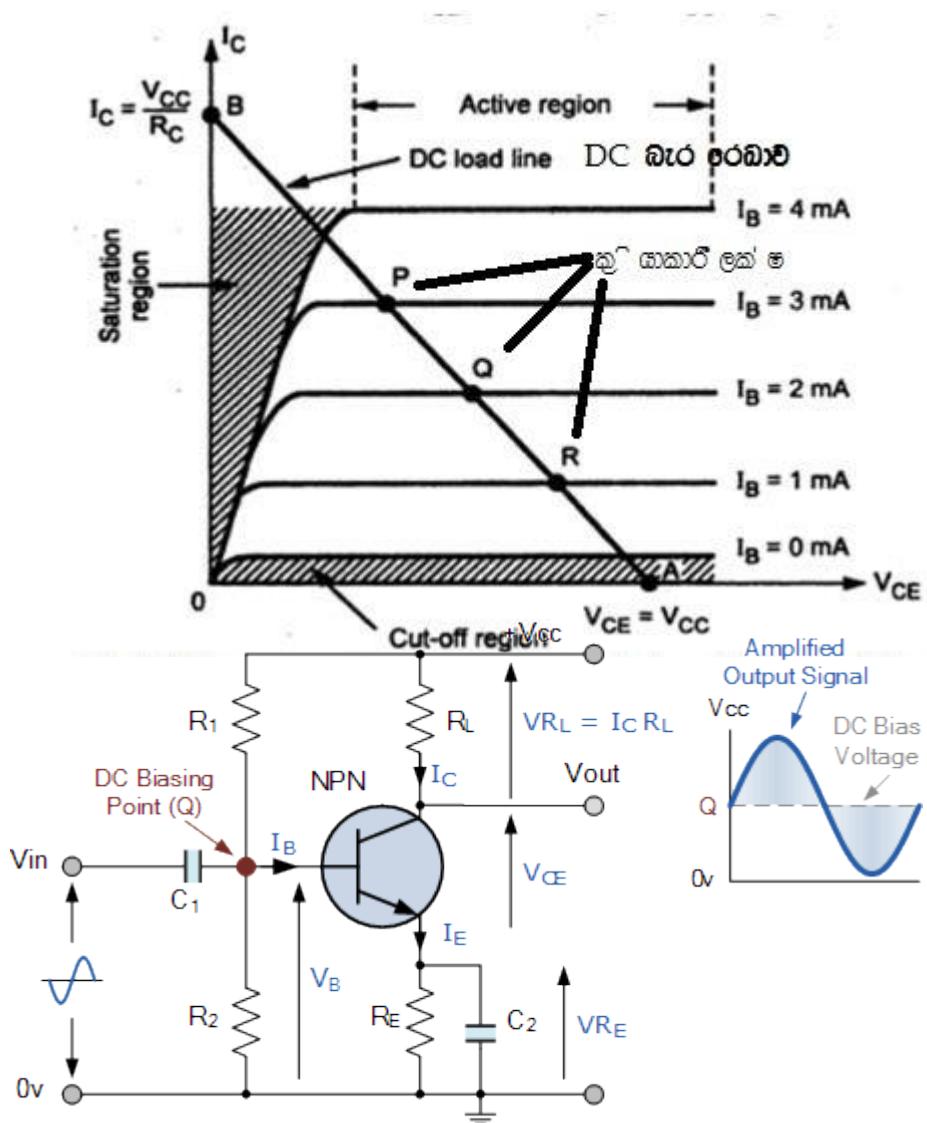
මෙම අවස්ථාවේදී  $I_C$  බාරාව 0 ලෙස සලකනු ලැබේ.

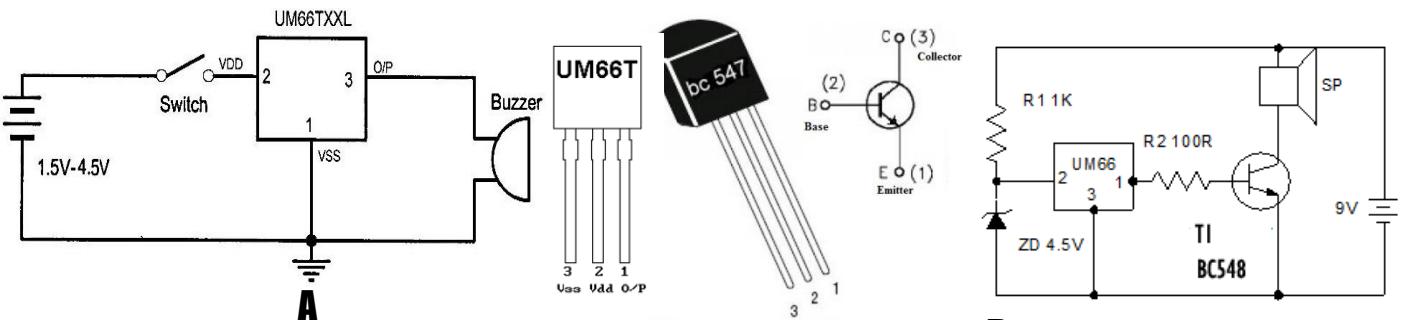
විවිධ  $V_{CC} = I_C \times R_L$  වේ

$$V_{CC} = V_{CE}$$

$$I_C = V_{CC}/R_L$$

මෙම ලක්ෂ දෙක ව්‍යුහ්සිස්ටරයේ ප්‍රතිඵලන ලාක්ෂණික වතුය මත සලකනු කළ විට පහත ආකාරයට දැක්වා ඇත.





ආන්සිස්ටරයක් වර්ධකයක් ලෙස නාවිතා වන ආකාරය ප්‍රායෝගිකව දැක්වෙන පරිපථයක් ඉහතින් දැක්වයි .

මෙම ඇටවුම් දෙක නිත් පුවරුවක පාස්සා ගැනීම හෝ ව්‍යාපෘති පුවරුවක සම්බන්ධ කරගන්න.

මෙති ඇති UM 66T ගුව්‍ය උත්පාදක සංශෑහිත : ( Small Memory IC ) පරිපථයක් වන අතර BC 547 npn ආන්සිස්ටරයක් වේ.

මෙය ක්‍රියාත්මකවේමේදී පහත ආකාරයට වියයුතු වේ.

**A** පරිපථයෙන් පිටවන ගබඳය බසරයෙන් ඇසේන අතර එය එනරම් වැඩි අයයක් නොවන අතර වර්ධනය සමානය අගයකි එය ප්‍රායෝගිකව දේළන්ක්ෂයකට ලබා දීමෙන් නිරික්ෂණය කළ හැක.

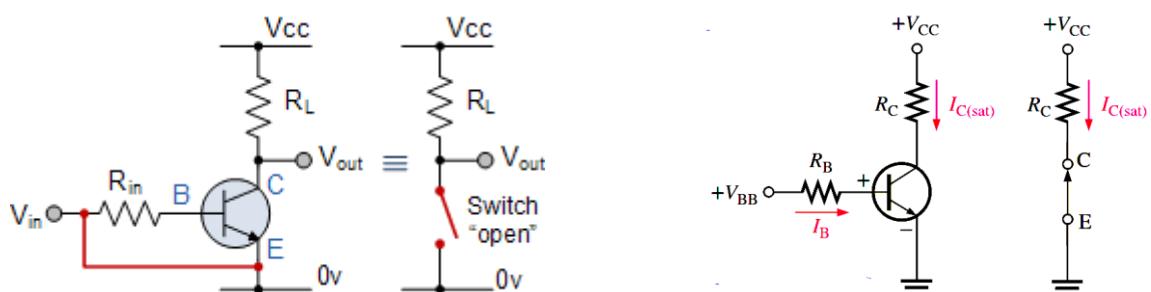
**B** පරිපථයෙන් පිටවන ගබඳය බසරයෙන් ඇසේන අතර එය **A** පරිපථයෙන් පිටවන ගබඳය ව්‍යාපෘති බව ඉවත් වේ.

මෙහි වැඩිපුර ගබඳ සහිත බවට පත්වූයේ සවිකර ඇති ආන්සිස්ටරයෙන් වන අතර එය IC න් පිටවන සංඛ්‍යාව වර්ධනයකට ලක්කර ඇත.

ජායාලී ඇති ගුව්‍ය වර්ධකයෙන්ද කෙරෙන්නේ ඉහත කාරණාවම වේ

2 ස්විචයක් ලෙස නාවිත වන ආකාර

ස්විචයක් ලෙස නාවිතා වන අවස්ථාවේදී ආන්සිස්ටරයේ නාවිතා කරන්නේ අක්‍රිය අවස්ථාව ( Cut off ) Off හා සංත්‍යුත අවස්ථාව ( Saturation ) On අවස්ථාවන් දෙකයි



එවිට මෙහි  $V_{BE} << 0.7V$  වේ

එවිට මෙහි  $V_{BE} > 0.7V$  වේ

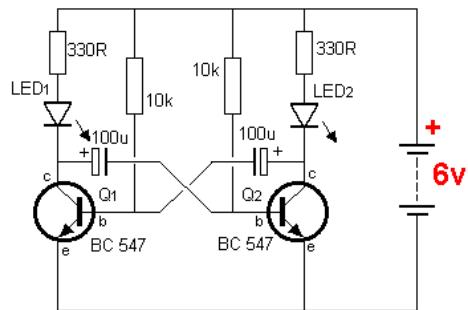
මෙම අවස්ථාවේදී  $V_{CE} = 0V$  වේ

ඡ්‍යායෝගිකව එම අගය  $V_{CE} = 0.1 - 0.2V$  අතරේ වේ

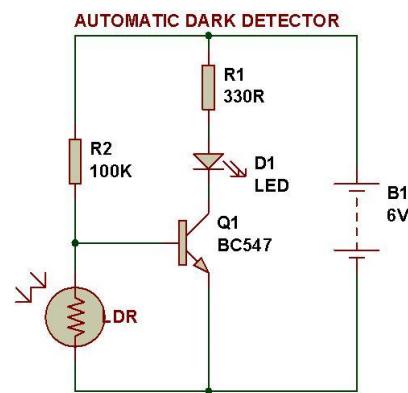
මෙම කාරණාව ප්‍රායෝගිකව දක්නට ලැබෙන පරිපථ කිහිපයක් පහතින් දක්වේ.

අ. බහු කම්පක පරිපථ සඳහා

(for Multi Vibrator Circuit)

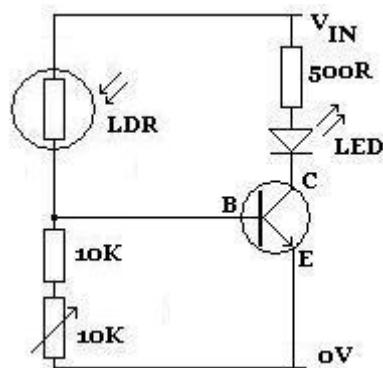


ආ. අදුරට සංවේදී පරිපථය

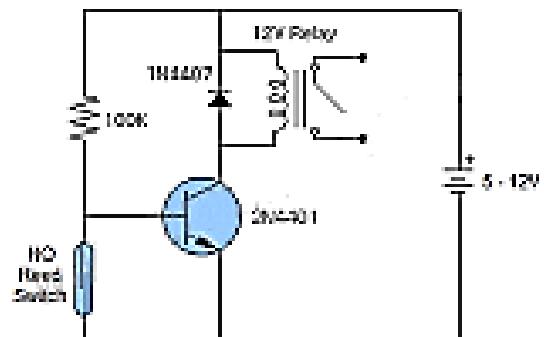


ඇ. ආලෝකයට සංවේදී පරිපථය

ඉ. ව්‍යුම්බක බව හඳුනාගන්නා පරිපථය



Automatic Garage Light



ඉහත පරිපථ වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා ක්‍රමවේදයන් දක්වන්න.

